毫米波地熱鑽探計畫(下)

張嘉君博士/歐懿中博士 國家同步輻射研究中心高頻小組

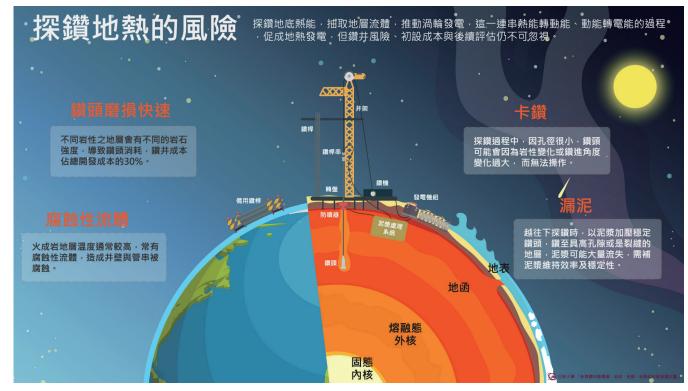
編者按:上一期簡訊中已介紹運用加速器毫米波技術來進行地熱鑽探計畫,說明台灣地熱優勢和傳統開採方法,本期接續介紹運用毫米波鑽探技術的優勢與挑戰。

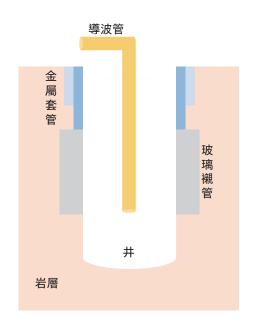
毫米波鑽探地熱深井的優勢與挑戰

毫米波鑽探技術的原理在於它藉由能量(高功率毫米波)與物質(岩石)的交互作用,取代鑽頭和井內的監控裝置等,因此避免了機械鑽鑿的磨損。傳統鑽頭總是和岩石硬碰硬,當遇到高溫高壓、高硬度岩層、酸性地下水等險峻的地質環境時,器械和設備經常磨損不斷甚至腐蝕,有時還因此中斷工作徒增成本,如圖一所示[1]。相較之下,毫米波藉由直接加熱並氣化岩石的方式將其結構破壞,不需接觸岩石就可以往下鑽探。這種非接觸式地移除岩層避免了機具的磨損和經常更換,降低維護成本,進而大幅縮短鑽探時間,提升效率。

為確保地熱井結構穩固,傳統鑽井技術每鑽進一定深度 時,即需要下放金屬套管,以防止井孔因壓力不平衡造成坍 塌或破裂。這項工作不但耗時又繁瑣,還需付出高昂的成本。相對而言,毫米波的技術提供一種更新穎的解決方案。這項技術的構想是利用毫米波將井底的岩石氣化的同時,由地面向井內提供高壓氣體,迫使高溫的岩石氣體滲入周圍岩壁的縫隙中。當周圍的岩壁被高溫岩石氣體入侵後,便會吸收其熱量,隨之逐漸升溫融化,最後冷卻形成玻璃化的結構[2]。這種結構如同在井壁周圍安裝了一層玻璃製的套管一般,有機會達到維持井孔穩定的效果。這種鑽鑿與固井同步進行的方式將有望顯著提升鑽井效率,將費時費力且耗資甚鉅的下套管工程化為一氣呵成的高效操作(圖二)。

在開採地熱能源的過程中,毫米波技術也展現出它的優勢。由於地層深處的高溫高壓 (例如地下 16 公里深處可達 400 °C,壓力可達 392 百萬帕) 使水處於超臨界狀態,若將超臨界狀態的水當作工作流體使用,引導到地面成為高焓值的過熱蒸汽,將可以進行高效的電力轉換,類似目前在使用的渦輪發電機;如果地熱井就在發電廠內,經由適當的改造現有的發電機組和電網,可以節省重建相關設備的費用和時間,避免資源浪費。





圖二 高功率毫米波束由導波管傳輸至目標岩層後,藉由直接氣化岩石向下鑽探地熱深井,可使用複合式固井方式,即淺層部份使用傳統金屬套管,較深處利用高溫岩石氣體向井壁滲透後形成的玻璃化結構,即為玻璃襯管 (glass liner)。

然而,這項想法目前正面臨一系列嚴峻的技術考驗。首先,毫米波技術對於操作環境的要求十分嚴格,從磁旋管和導波管的設計,到冷卻和熱管理系統,再至井下壓力控制和高溫岩石氣體排開等,每個環節都須精確掌握,才能確保能量得以有效傳遞。若這些高溫岩石氣體未能如預期地清除,可能導致鑽井速率降低;若冷卻系統的設計或操作有誤,或者井孔內壓力失控,導致磁旋管或導波管的毀壞,將損失可靠?厚度和抗壓強度是否足夠?這些都需要仔細計算評估與實驗驗證。另外,製作高功率的磁旋管和導波管所需的資金也相當可觀,這對整體的投資報酬與風險管控無疑是一大挑戰。雖然這項技術在長期運行中有望降低成本,但初期投入的高昂費用仍然是亟需克服的難題。再者,這項技術的應用需要較廣的專業知識和操作經驗,因此對於相關技術人員的培訓和設備操作要求也比較高。

總體而言,毫米波地熱鑽探是一項革新想法,它能藉由 提高毫米波的功率密度提升鑽探效率,並應對困難的地質條 件。相較於傳統鑽探技術,毫米波技術有機會可以鑽得更快 更深,獲取更深處的地熱能源。儘管目前仍有許多山頭需要 攻克,但若有更多人力及研究資源投入,這些問題有望逐步 解決。

談地熱資源的公平性及全球影響

地熱資源具有全球普適性,無論是先進或發展中國家, 其下深處的地層都儲存著源源不絕的熱能。透過毫米波地熱 開採技術的引進,即使是天然資源較為匱乏的地區,也有機 會開發過去無法觸及的深層地熱,實現能源自主和經濟發展,進而提升生活和教育水準,為全球能源轉型與永續發展 提供新的契機。

參考文獻

- 1. 世新大學新媒體科普傳播: 地球、地質、地熱能科普推廣計畫
- 2. K. D. Oglesby et al., Impact Technologies LLC (2014).

用戶資訊

實驗計畫申請

- 2025-2 期實驗計畫申請目前審核中 2025 年第二期 (2025 年 7 - 12 月)實驗計 畫申請目前正陸續進行初複審中,核定的光 束線排程後續將於 6 月初公告於用戶入口網 首頁。
- 2026-1 期實驗申請預告
 2026 年第一期(2026年1-6月)光束線使用預計2025年7月初開放申請,截止日期為2025年8月15日(五),歡迎計畫主持人踴躍上網申請。

近期開放光束線如下

- TPS 09A2 Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy for Semiconductor (高能 X 光光電子發射能譜 前瞻半導體)
- TPS 15A1 Micro-crystal X-ray Diffraction (微米晶體結構解析)
- TPS 25A2 Coherent Diffraction Imaging (同調 X 光影像)
- TPS 27A1 Soft X-ray Nanoscopy (軟 X 光 奈米顯微術)
- TPS 32A1 Tender X-ray Absorption Spectroscopy (柔 X 光吸收光譜)

其他資訊

- 實驗排程期間,實驗成員若需住宿本中心宿 舍,請完成以下流程:
 - 計畫主持人須先於「實驗安全核可表」勾 選實驗成員。
 - 2.住宿者務必於實驗開始 3 個工作日前完成 線上預訂,逾期無法受理。
 - 3. 本中心宿舍申請及使用採實名制。